

デモラインご活用ください ドライエッチング装置

Model : NE-550

◆研究開発向けに最適なモデル 幅広いプラズマ制御が可能

特徴

- 2008年製装置をリファーマビッシュ
- 有磁場ICP方式
- 堆積膜付着防止用「スター電極」搭載
- 各サイズESC (4",6",8")準備
- F、Cl系ガス系統あり
- エンドポイントモニター実装



構成

項目	構成
Type	ロードロック式
チャンバー構成	ISM Etching×1室 (EPM有)
Process P/S	Antenna 1kW / Bias 0.6kW
Stage仕様	ESC 設定温度範囲 : -20℃～90℃
Gas系統	O2:99sccm、Ar:140sccm、 CF4 or SF6:89.2sccm、 CHF3:102sccm、C3F8 or C4F8:86sccm、 BCl3:88.4sccm Cl2:168.2sccm、SiCl4:62sccm
対応基板	4,6inch オリフラ 8inch ノッチ インチ切替えに事前準備1W必要
真空ポンプ	TMP

ご相談ください

- エッチング試作、検証
- 現象解析
- 操作性確認
- 中古機導入検討

ご相談はアルバックテクノへ

サンプリング
サポート紹介



お問合せ



NE-550_1.7

ULVAC